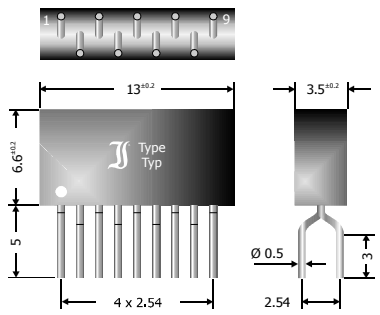
DAN403 (200 mW)

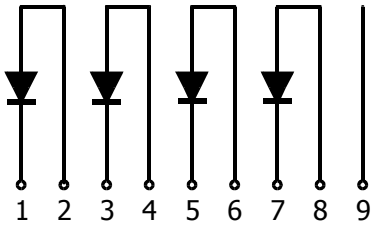
Small Signal Diode Arrays
Diodensätze mit Allzweckdioden

Version 2008-04-15



Dimensions - Maße [mm]

Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
9-pin Plastic case 9-Pin Kunststoffgehäuse	13 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	0.8 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



4 independent elements – 4 einzelne Bauelemente

Maximum ratings **Grenzwerte**

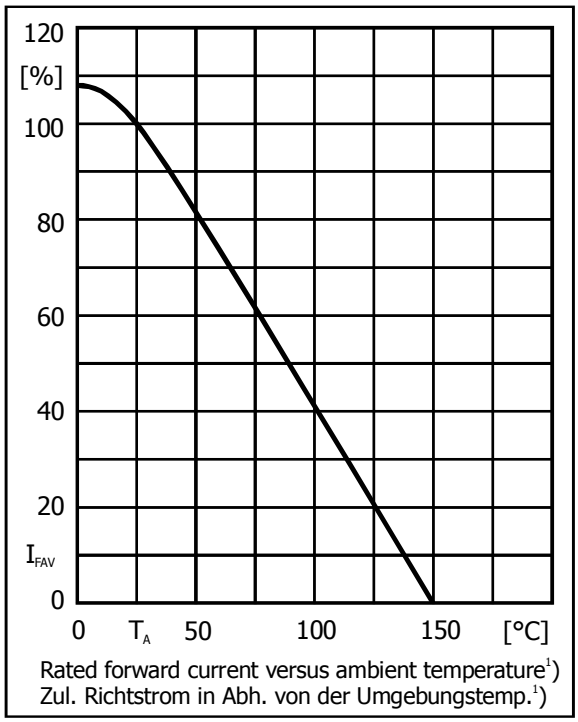
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [1]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] [1]
DAN403	80	80

Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	T_A = 25°C	 I_{FAV} I_{FAV}	 100 mA [2] 50 mA [2]
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	T_A = 25°C	 I_{FAV} I_{FAV}	 100 mA [2] 50 mA [2]
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

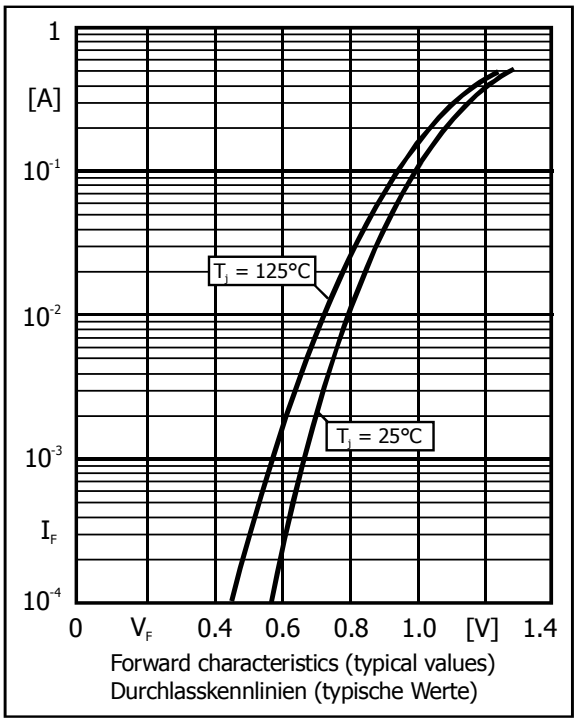
1 Per diode – Pro Diode
2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

© Diotec Semiconductor AG

Characteristics			**Kennwerte**
Forward voltage Durchlass-Spannung	T_j = 25°C I_F = 10 mA	V_F	< 1.0 V [1])
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25°C V_R = 20 V	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	I_F = 10 mA through/über I_R = 10 mA to I_R = 1 mA	t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thC}	< 85 K/W [2])



Rated forward current versus ambient temperature[1])
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.[1])



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

1 Per diode – Pro Diode
2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

© Diotec Semiconductor AG